

### **Сведения об официальном оппоненте**

по диссертационной работе Бабинцева Ильи Александровича «Исследование кинетики мицеллообразования и релаксации сферических и цилиндрических мицелл на основе уравнения Беккера-Дёринга», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 – Теоретическая физика

### **Кукушкин Сергей Арсеньевич**

доктор физико-математических наук, специальность 01.04.07 – Физика твердого тела

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН), лаборатория структурных и фазовых превращений в конденсированных средах, заведующий лабораторией.

Список основных публикаций по сходной тематике в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Фазовый переход первого рода через промежуточное состояние // ФТТ. Т. 56, (2014), вып. 4, с. 761-768.
2. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, А.В. Редьков, Критерий морфологической устойчивости сферического фронта кристаллизации в многокомпонентной системе с химическими реакциями. // ФТТ, т. 56, (2014), вып. 12. с. 2440-2445.
3. А.С. Гращенко, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, Наноиндентирование и деформационные свойства наномасштабных пленок карбида кремния на кремнии. // Письма в ЖТФ, 2014, том 40, выпуск 24, с. 53-59.
4. В.Н. Бессолов, Е.В. Коненкова, С.А. Кукушкин, А.В. Мясоедов, А.В. Осипов, С.Н. Родин, М.П. Щеглов, Н.А. Феоктистов, Эпитаксия полуполярного GaN на подложке Si(001) с буферным слоем SiC // Письма в ЖТФ, 2014, том 40, выпуск 9, с. 48-54.
5. S.A. Kukushkin and A.V. Osipov. Topical Review. Theory and practice of SiC growth on Si and its applications to wide-gap semiconductor films. // J. of Phys. D: Appl. Phys., 2014, 47, p. 313001-313041.